## C-9 パルスレーザー堆積法により成膜した

## [(CaFeO<sub>x</sub>)<sub>n</sub>/(LaFeO<sub>3</sub>)<sub>n</sub>]<sub>m</sub>人工超格子及び積層膜の磁気特性

## Magnetic properties of [(CaFeO<sub>x</sub>)<sub>n</sub>/(LaFeO<sub>3</sub>)<sub>n</sub>]<sub>m</sub> Superlattices and Multilayer

**Deposited by Pulsed Laser Deposition Method** 

○岡本卓也<sup>1</sup>,平岡恭也<sup>1</sup>,寺地勇博<sup>1</sup>,陳曦<sup>2</sup>,齋藤凌輔<sup>2</sup>,岩田展幸<sup>3</sup>

\*Takuya Okamoto<sup>1</sup>,Kyoya Hiraoka<sup>1</sup>,Takehiro Teraji<sup>1</sup> Tin Gi<sup>2</sup>,Ryousuke Saitou<sup>2</sup>,Nobuyuki Iwata<sup>3</sup>

#### Abstract:

Although both CaFeO<sub>3</sub>(CFO3)/LaFeO<sub>3</sub>(LFO) layered structure are antiferromagnetic materials, it is considered that the CFO3/LFO multilayer undergo ferromagnetic transition by applying an electric field or by the thickness of the LFO layer. In this report, CaFeO<sub>x</sub>(CFO)/LFO multilayer and superlattice were made, and magnetic characteristic evaluation was carried out. When 17.1 units of the multilayer film were formed, a saturation magnetization of  $M_s t = 16.2 \times 10^{-5}$  [emu/cm<sup>2</sup>] was observed. In the superlattice, oxygen deficiency of the CFO layer became remarkable, and saturation magnetization by ferromagnetic coupling in the CFO layer was observed. From these results, it is concluded that the CFO3 ratio plays an important role in the control of the magnetic properties in both layered films and superlattices.

#### 1.背景・目的

SrTiO<sub>3</sub>(STO)基板上に成膜した LaAlO<sub>3</sub>(LAO)薄膜は、基板、薄膜共に非磁性体であるにもかかわらず、その 一部に面内容易軸の弱強磁性を有し、電界印加により、室温において磁化反転が観測されている[1]。この分 野の研究は、強磁性(FM)発現の有無も含めていまだに議論がなされている[2-4]。本研究の目的は、Ti や Al で はなく磁性原子である Fe を用いて STO/LAO 構造と類似の酸化物ヘテロ構造を作製し、室温において FM 長 距離秩序を誘起し、電界印加による磁気特性制御を行う事である。

本研究では、両者とも反強磁性(AFM)絶縁体である CaFeO<sub>3</sub>(CFO3)、LaFeO<sub>3</sub>(LFO)を選択した。CFO3/LFO 積 層膜に電界印加をすることで界面を通して電子移動を引き起こし、反強磁性-強磁性相転移を制御することが 最終的な目的である。電子移動が無い状態であれば、積層膜は AFM を示す。電子移動によって界面近傍で は、膜面内および面直方向に Fe<sup>4+</sup>(3d<sup>4</sup>)-Fe<sup>3+</sup>(3d<sup>5</sup>)の FM 的結合が発生し FM 秩序が誘起されると考えている。

STO/LAO 構造における磁性発現を説明する一つの解釈に Polar Catastrophe Model がある[5-7]。無極性の STO 基板上に極性をもつ LAO の堆積数を増加させていくと、LAO の静電的なポテンシャルエネルギーも同時に 増加し、Al から Ti に電子移動することで、エネルギーが緩和される。この時、Ti<sup>3+</sup>となって 3d 軌道に 1 個の 電子が導入する。これが FM の起源となる。同様のモデルを CFO3/LFO 積層膜にも適用すると、無極性であ る CFO3 膜上に極性をもつ LFO の堆積数を増加させると LFO 層の Fe<sup>3+</sup>から CFO3 層の Fe<sup>4+</sup>に電子が移動し、 FM 長距離秩序が誘起されると考えている。この FM 秩序の誘起は LFO 層の堆積数と電界によって制御でき る可能性がある[8]。また、同材料で超格子構造を作成することで、巨大な電気磁気(ME)効果を期待する。 STO(001)基板と CFO3、LFO の格子ミスマッチは、それぞれ-3.35%、+0.666%である。STO 基板に対してプラ スマイナスの格子ミスマッチであるため、面内の平均格子定数が基板と整合し良好な積層膜が成長すると考 えられる。しかしながら、Fe<sup>4+</sup>は非常に不安定であるため、一般的な薄膜作製法では Ca<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(CaFeO<sub>2.5</sub>:CFO2.5) が成長しやすい傾向にある。STO 基板上では CFO3 が数層成長した後、CFO2.5 が成長する[9-11]。CFO3-CFO2.5 相内の Fe<sup>4+</sup>(3d<sup>4</sup>)と Fe<sup>3+</sup>(3d<sup>5</sup>)間で FM 的結合が発生し、界面以外での強磁性が発生していると予想している。 そのため、CFO3 の存在比が積層膜及び超格子の磁気特性に与えると考える。

# 2. 実験方法

2. 1基板処理条件

基板は、Nb ドープした STO(Nb-STO)(001)を使用した。成膜に 使用した Nb-STO 基板はアセトン、エタノールによる超音波洗 浄後、純水、バッファードフッ酸(BHF:pH=5.0)にてエッチングを 行った。その後、アニール処理を 920℃ で 4 時間行った。 2.2パルスレーザー堆積法による成膜

KrF エキシマレーザー(波長 248 nm)を用いて、パルスレーザー 堆積(Pulsed Laser Deposition:PLD)法により成膜を行った。ヒータ 温度 670°C,酸素雰囲気 20Pa、エネルギー密度 1.5 または 2.1 J/cm<sup>2</sup>、周波数 4Hz とした。Fig1.に成膜した薄膜の模式図を示す。 積層膜においては CFO の堆積ユニット数は 3 と固定し、LFO の 堆積ユニット数は 3 から 15 まで変化させた。超格子構造におい ては CFO,LFO の堆積数は 3,5,7 ユニットで変化させ、堆積サイ クル数は 14,20,33 サイクルと変化させた。堆積したユニット数 は、反射型高速電子線回折(RHEED)の反射強度の挙動を観察し て確定した。



Fig.1 Film design of CaFeO3/LaFeO3 Films

### 3. 評価方法

#### 3. 1X 線反射(X-Ray Reflectivity: XRR)測定

XRR(20が1~8°程度の低角度20-0測定)測定結果は、膜の平坦性、界面の清浄性、膜厚、周期性等の情報を含んでいる。CFO/LFO積層膜の構造をモデリングして、XRR測定結果をフィッティングすることにより、成

膜された CFO,LFO 層の膜厚を算出した。CFO 層内は酸素欠損による CFO2.5 の成長を考慮し解析を行い、 CFO 層内の CFO3 の存在比率を算出した。また、超格子構造においては、XRR 測定の結果を成膜結果へとフ ィードバックし、高度な成長制御を可能とした。 3.2磁化測定

SQUID(超伝導量子干渉素子)を使用した VSM 測定は均一磁界中においた試料を一定周波数、一定振幅で 振動させ装置内の検出コイルに誘起される誘導起電力を元に試料の磁化を決定する事ができる。測定磁場範 囲を-7T~7Tの範囲内、温度を 5~300K の範囲内で測定した。測定磁場はサンプル表面に対して垂直な方向に 印加した。

4. 結果及び考察

4. 1 CaFeO<sub>x</sub>/LaFeO<sub>3</sub> 積層膜の膜厚に対する磁気特性 Figure 2 に CaFeO<sub>x</sub>/LaFeO<sub>3</sub> 積層膜の XRR 測定結果 から算出した LFO 層の膜厚に対する単位面積当たり の飽和磁化 *M<sub>st</sub>* を示す。積層膜において LFO の膜厚 が 17.1 ユニットの積層膜において *M<sub>st</sub>*=16.2×10<sup>-5</sup>[emu/cm<sup>2</sup>]の大きな磁化が観測された。LFO の膜厚を 増大させていくと、静電的エネルギーが増加し LFO のユニット数が 11.6~17.1 ユニットの間で界面を通し て電子移動を行い、CFO/LFO 間で強磁性的な結合を 誘起したものであると考える。

4. 2 CaFeO<sub>x</sub>(CFO)層の酸素欠損が磁気特性に与える 影響

Figure 3 に XRR 測定結果よりフィッティングを行 い算出した CFO 層内の CFO3 の存在比率に対する Mst のグラフを示す。積層膜に対して超格子は CFO 層内 の CFO3 の存在比率が少なく、酸素欠損が多い。Fe4+の 不安定性により超格子においては CFO3 の成長制御が 難しいことがわかる。CFO、LFO ともに反強磁性体で あるため、本来であれば磁化を持たないが、CFO3の存 在比率が 40~60%付近で Mst=1~8.4×10<sup>-5</sup>[emu/cm<sup>2</sup>]の飽 和磁化が観測されている。これは、CFO3/CFO2.5間の 強磁性的な結合に起因するものであると考えている。 CFO3の存在比率が 60%以上の試料では、CFO 層内の CFO3 が支配的であり LFO との界面での結合がなけれ ば磁性を示さない。同様に CFO3 の存在比率が 40%以 下の試料では、CFO2.5 が支配的であり強磁性的な結合 に要する対となる原子が存在せず、磁性を示さないと 考える。しかし、超格子において 20~40%付近の 3 点 で M<sub>st</sub> =4~8.5×10<sup>-5</sup>[emu/cm<sup>2</sup>]の飽和磁化が観測されてい る、CFOの膜厚が3ユニットの薄い膜であること、酸 素欠損による粗い界面で CFO3 と LFO の拡散による 混合層が形成されていることが磁化起源になっている のではないかと考えられる。



Fig.2 Saturated Magnetization versus LFO thickness



ratio of CFO3 in CFO layer

4.まとめ

Nb-SrTiO<sub>3</sub> 基板上に CFO/LFO 積層膜及び超格子を成膜した。積層膜,超格子ともに XRR 測定によるフィッ ティングを行い、膜厚,CFO3 の存在比率を算出した。超格子は成膜に XRR の結果をフィードバックし、成 膜条件の最適化を行った。作成した試料を SQUID-VSM にて-7T~7T の範囲で磁気測定を行い、CFO3 の存在 比率と LFO の膜厚に対して評価した。結果より LFO の膜厚に依存して、飽和磁化が増大し、反強磁性-強磁 性転移が誘起されたと期待している、また CFO3 の存在比率が 40~60%付近で、CFO3/CFO2.5 間の強磁性結 合と見られる磁化の増大が観測された。このことから CFO/LFO 積層膜及び超格子における磁気特性制御に は CFO3 の成長制御並びに膜厚に依存した強磁性転移の制御が重要であると言える。

5.参考文献

[1] Feng Bi, *et al*, Nature communications, **5**, 5019(2014).[2] Fitzsimmons, M.R. *et al*. Phys. Rev. Lett. **107**, 217201 (2011).[3] Z. Gao et al., Adv. Mater. Interfaces, **5**, 1701565 (2018).[4] M. Yang, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces **10**, 9774 (2018).[5] A. Ohtomo and H.Y. Hwang, Nature **427**, 423 (2004).[6] J. Mannhart, et al., MRS Bulletin **33**, 1027 (2008).[7] N. Nakagawa et al., Nat. Mater. **5**, 204 (2006).[8] S. Thiel, et al., Science **313**, 1942 (2006).[9] N. Iwata, et al., Mater. Res. Soc. Symp. Proc. **1292**, 125 (2011).[10] Y. Watabe, et al., Jpn. J. Appl. Phys. **53**, 05FB12 (2014).
[11] N. Iwata, et al., Jpn. J. Appl. Phys. **53**, 05FB20 (2014).

<sup>1:</sup>日大理工・院(前)・電子 2:日大理工・学部・電子3:日大理工・教員・電子